®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-74128

@Int Ci.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 4月4日

G 11 B 7/125

A-7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**匈発明の名称** 光ヘッド

②特 願 昭61-218097

20出 願 昭61(1986)9月18日

**砂発明者 浮田 宏生** 

東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会

社電子機構技術研究所内

母 発明 者 片桐

洋 雅

東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会

社電子機構技術研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

②代理人 弁理士 光石 士郎

外1名

明 細 書

#### 1. 発明の名称

光ヘッド

#### 2.特許請求の範囲

- (1) 半導体レーザの一方の出力端面に光記録媒体、他方の出力端面に光検出器を配置し、該 光記録媒体の反射光を該半導体レーザに帰還 し、複合共振作用により情報の再生を行う 光記録媒体近接浮上形の光ヘッドにおいて、 半導体レーザの駆動電流を発振しきい値以下 に設定することを特徴とする光ヘッド。
- (2) 上記半導体レーザの駆動電流を発振しきい 値の 0.8倍から 1.0倍にしたことを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の光ヘッド。

#### 3.発明の詳細な説明

#### <産業上の利用分野>

本発明は、半導体レーザと光記録媒体との 複合共振作用を利用した超小形、低価格の光 ヘッドに関し、情報再生信号品質を改善した ものである。

#### <従来の技術>

従来この種の光ヘッドは例えば、宮沢他: "PCMデッキ用半導体レーザビックアップ"。 電子材料、p.67、1979年2月号 にあるよう に第7図に示す構造になっていた。即ち半説 体レーザ1の出射光はカップリングレンズ 2. 集光レンズ3を経て光記録媒体4上に 集光される。 光記録媒体 4 での反射光は上記 と逆の光路を経て半導体レーザ1に帰還され る。この場合の光出力を半導体レーザ1の 後端に設置された光検出器5で検知する。6 および7は焦点談差信号、トラック談差信号 を得るためのウオーブリング素子で例えば PZT混子を使用する。発根器Bおよび9は P Z T 素子 6 , P Z T 素子 7 を駆動し光記録 媒体4と垂直方向に微小振動させる。焦点 誤差信号、トラック誤差信号は位相検波器10 および口でこの時の上記帰還光を位相検波し て得られる。図中、12は支持パネ、13は焦点

制御用アクチュエータ、14はトラック制御用アクチュエータである。

以上述べたように、従来の光ヘッドでは情報再生時に半導体レーザを、常時レーザ発振状態にし、集光レンズ3を微小振動させて焦点誤差信号を得る必要があった。このため、光帰遠に起因するモードホップノイズが発生し信号の品質が悪いという欠点があった。

#### <発明が解決しようとする問題点>

光へッドの構成を簡略化し、小形・低価格化を図る一案として戻り光を積極的に利用したSCOOP方式が提案・検討されている。 この方式では焦別のため半導体があり、ではない。 は常に低出力発振状態にあり、低いードが、カケに低出力発振状態にあり、低低体状態にあり、低低体状態があった。そこで光へッドを振いたにいる。 近接により信号を表示といいて、 はないでは、まり信号を対し、からないではないではないではないではないではない。 場合について次の様な実験を行った。即させ、 8 図に示すようにLDと反射板を対向

#### <問題点を解決するための手段>

斯かる目的を達成する本発明の構成は半導体レーザの一方の出力端面に光記し、該媒体の位方の出力端面に光線出器を配置し、該光記録媒体の反射光を該半導体レーザに帰還し、強媒体の反射光を設け情報の再生を行う光記は媒体上形の光へッドにおいて、半導体レーザの駆動電流を発振しきい値の 0.8倍から1.0 倍にするのが望しい。

#### < 実 施 例 1 >

第1図(a),(b)は本発明の第1の実施例である。第1図(a) は光ヘッドの使用状態図、第1図(b) は光ヘッドの構成図である。光ヘッド21は幅、深さが数皿の分離満32により、半導体レーザ1と光検出器5に分けられている。33は半導体レーザ基板、34は活性圏、35は絶縁層、36は半導体レーザ電極、37は光検出器電極、38は受光部、39は共通電極で

本発明の目的は、光ヘッドをスライダに装着し、スライダを光記録媒体上に近接浮上させることにより、半導体レーザをレーザ非発振状態において合焦点させることを可能とし、上記欠点を解決し高品質の信号の得られる光ヘッドを提供することにある。

ある。第1図(a) に示すように光へッド21 光へッド21は光れる。即ち、光へッド21は光記録媒体4の半径方向へ高速移動できるアーム22上の負荷バネ23に取りつれたのからの大力を表し使用される。これを3のである。光へッド21の焦点制御は負荷バス23の研集を10年で決まる。半導体4の走行速度で決まる。半導体4で反射を10世界である。半導体4で反射が半導体レーザ1に帰避し、その時の光出力(複合共振信号出力)42を受光部38で検知する。

この結果、光記録媒体4の反射率の変化 (情報ビットの有無)に対応し光出力42が第 2図に示すように変化(H. L)し、データ 信号を得る。この時の駆動電流Iと信号出力 の変調度の計算値を第3図に示す。

この計算では、半導体レーザの I し特性 (光出力対駆動電流特性)を実験値を用い 次のように近似した。

P=0.3 1 (mW) -- (1≤1.02459 lth) --- (1)
P=12.5 (I-Ith) (mW) --- (1>1.02459 lth) --- (2)
ここで I は駆動電流、 I thはレーザ発振しき
い値電流である。また光記録媒体 4 の反射率
R f による I thの変化は

I th∞ 1 - (1 - R1) η √Rf … … (3) となる。ここで R I は半導体レーザ 1 出力端 面の反射率 (例えば 0.32)、ηは帰還光の光 結合効率 (例えば 0.5)である。また光記録媒 体 4 の反射率はビットの有無により

Rf(H) = 0.4

R f(L) = 0.05

とした。これは代表的追記媒体に対応するものである。一方、第4図は相変態形背替媒体に対する計算結果で、

R f(H) = 0.4

R f(L) = 0.25

の場合である。

以上の結果から、再生信号品質を表す変調

ことがわかる。これは温度や駆動電流に対す るマージンを狭めることになる。

このような場合には半導体レーザに温度 検出手段を設け、半導体レーザの温度変化に 対応する発振しきい値のずれ分を、半導体 レーザの駆動電流に加算することにより光出 力の変動を仰圧することができる。

第1図(c) は同図(b) に示す実験例の変形例に相当する実施例である。即ち、第1図(c) に示す実施例は先端に導被形レンズ部60を配したもので光記録媒体4上での光ビームスポット61を縮小し、記録密度を向上することができる。62は微細加工技術により形成されたエッチドミラー面で導波形レンズ部60を形成するバッファ層63(例えばSiOz)・導波路局64(例えばガラス7059)に接する。65はルネブルグレンズで導波路層64より高屈が平の誘電材料(例えば SiN)より成り周囲が円形、表面が半円状の形状をなしている。動作は第1図(b)と同じである。

度 (P2-P1)/ (P2+P1) は

I / I th < 1 --- (4)

で位大値を有することがわかる。

また、変調度が最大値を示す駆動電流値は光記録媒体4の反射率Rf(II)。Rf(L)等で変化するが、ほぼ、0.8~1.0の範囲にある。

なお、この駆動電流は場子43を通じ注入される。また、端子44からは光出力42の光電流が検出される。この光電流は半導体レーザ1の出力端面の反射率 R 2 を低減することにより増大できる。具体的には出力端面に透明誘電体を 2 / 4 の厚さ形成した反射防止膜による。

第5図は、光ヘッドの環境温度が変化した場合の変調度と半導体レーザ駆動電流の関係である。実線が計算値で破線が実験値である。同図より実験値は計算値に比べ、変調度がピークになる電流値はどの温度に対してもほぼ一致するが、変調度の山は低く幅は狭い

#### < 実 施 例 2 >

第6間は本発明の第2の実施例の光ヘッド である。第1の実施例と同様先端にレンズを 配敵しても良い。この光ヘッドは光記録媒体 として相変態形書替媒体を想定したもので、 40-1 は消去用光ピーム、40-2 は記録用光 ピーム、40-3 は再生用光ピームである。消 去用光ビームの近視野像は輸比が約10対1の 楕円であり、記録用光ピーム、再生用光ピー ムの近視野像は軸比が約1対1の円である。 前方の楕円光ピームで消去しながら中程の円 光ビームで記録、後方の円光ビームで再生す る。これにより情報のオーバライトと記録情 報の読み取りチェックが同時に可能となり、 この光ヘッドと相変應形掛替媒体を組合せる ことにより、極めて高性能の光記録再生装置 を実現できる。

このようなマルチ光ビームは幅、深さが 数皿の絶縁溝50により3個の半導体レーザ1 の出射光として実現される。さらに絶縁溝

#### 特開昭63-74128(4)

32により 3 個の光検出器 5 が作成される。なお、36-1,36-2,36-3 は半導体レーザの電極、37-1,37-2,37-3 は光検出器の電極、39は共通電極である。また、38-1,38-2、38-3 はそれぞれの光検出器の受光部である。これらの絶縁満32、50は例えば反応性イオンビームエッチングにより半導体レーザ基板上に作成される。半導体レーザ1と光検出器 5 は個別の部品であってもよい。

#### く発明の効果>

以上説明したように、本発明による光へッドはスライダに装むされ空気和滑作用により、光記録媒体上に近接浮上して用い、半導体レーザをレーザ非発振状態で合焦点させることが可能なので情報再生時に光帰還に起因するモードホップノイズが発生しないという利点がある。

さらに本発明の光ヘッドの半導体レーザ 駆動電流が信号変調度が最大になる条件に

浏 面 中、

1は半導体レーザ、

4 は光記録媒体、

5 は光検出器、

31は光ヘッド、

32位絶縁講、

38は受光部、

40は光ビーム、

41は反射光、

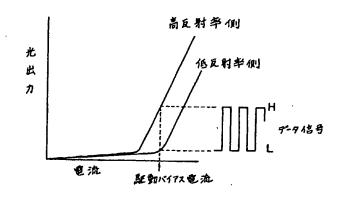
42は光出力である。

設定されているので、情報再生時の信号品質 が高いという利点がある。

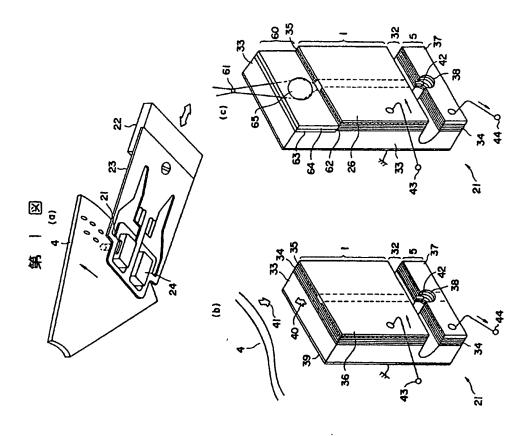
#### 4.図面の簡単な説明

第1図(a)(b)は本発明の第1の実施例に係り、同図(a)は光ヘッドの使用状態図、同図(c)は同図(b)の変形例を示す構成図、同図(c)は同図(b)の変形例を示す構成図、第2図は複合共振明明による信号検出の原理図、第3図は本発明による光へッドの信号変調度と半導体レーザ動動電流の第1の関係図、第4図は本発明による流のドの信号変調度と半導体レーザ駆動で、2の関係図、第5図は本発明による流が下のは号変調度と半導体レーザ駆動で、2の関係図、第5図は本発明による流が下ので、2の関係の光へッド構成図、第6図は本発明の光へッドでの変更の光へッド構成図、第6図は大量の光へッド構成図、第1回は表現で、第1回に表現である。

### 第 2 図

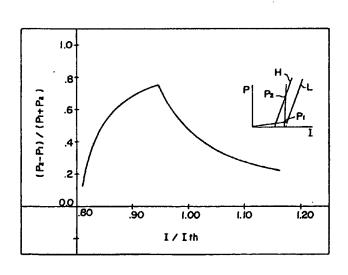


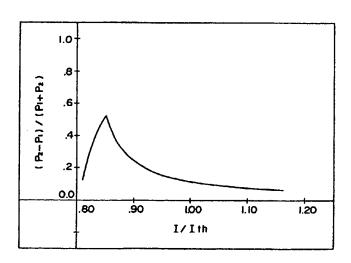
## 特開昭63-74128(5)



第 3 図

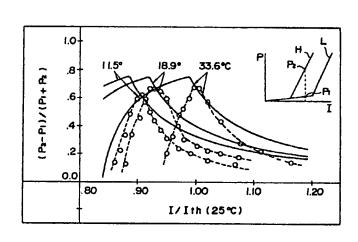
第 4 図

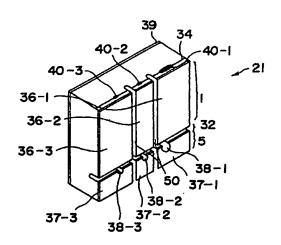




第 5 図

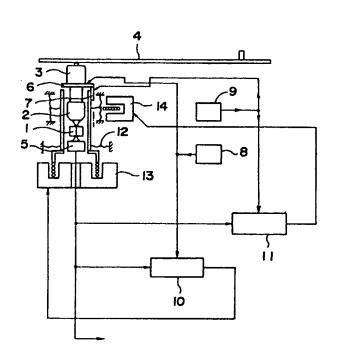
第 6 図

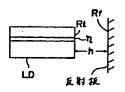




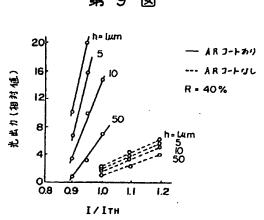
第 7 図

第 8 図





第 9 図



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
$\square$ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.